

ТЕХНОЛОГИЯ И КОНСТРУИРОВАНИЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЕ

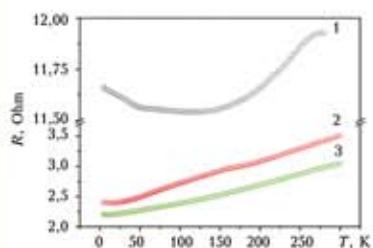


Fig. 1. Temperature dependence of the resistance of deformed InSb samples with different the concentration of charge carriers in the vicinity of the metal dielectric transition (in cm^{-3}):
1 – $6 \cdot 10^{16}$; 2 – $2 \cdot 10^{17}$; 3 – $6 \cdot 10^{17}$

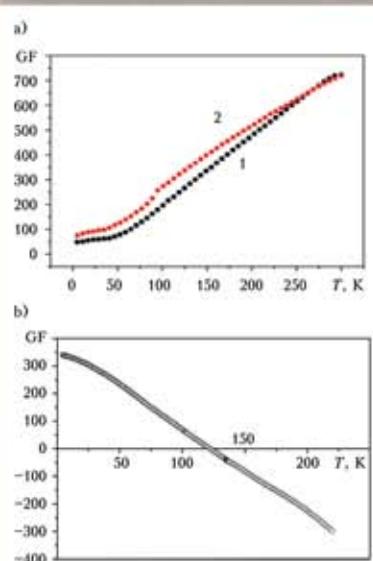


Fig. 2. Temperature dependence of the gauge factor for InSb microcrystals with different the concentration of charge carriers (in cm^{-3}):
a) 1 – $2 \cdot 10^{17}$; 2 – $6 \cdot 10^{17}$; b) $6 \cdot 10^{16}$

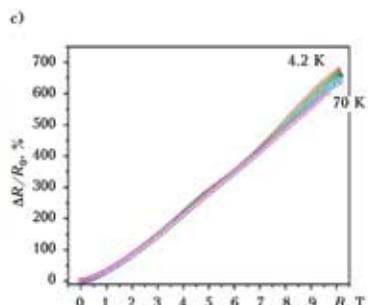
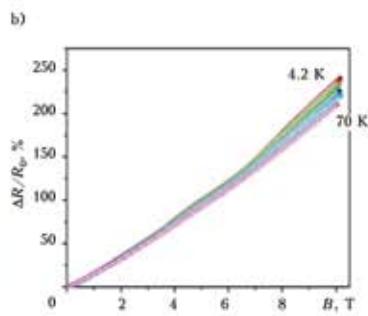
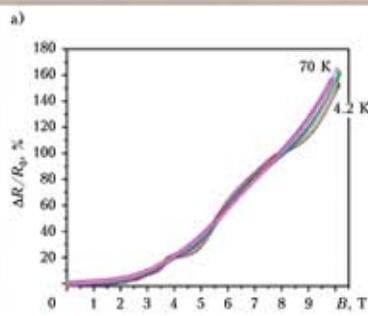


Fig. 3. Transversal magnetoresistance of InSb whiskers with different tin concentration (in cm^{-3}) for strained samples at temperature range 4.2–70 K:
a – $6 \cdot 10^{16}$; b – $6 \cdot 10^{17}$; c – $2 \cdot 10^{17}$

До статті
«Deformation-induced effects in indium antimonide microstructures at cryogenic temperatures for sensor applications»

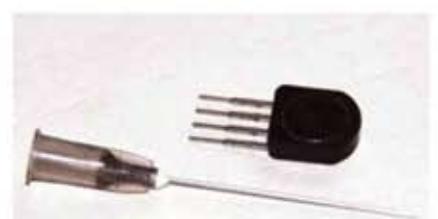


Fig. 4. Typical view of sensors of physical quantities

3–4 2019

МАЙ — АВГУСТ

**НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
«ТЕХНОЛОГИЯ И КОНСТРУИРОВАНИЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЕ»**

ISSN 2225-5818

Выходит один раз в 2 месяца

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

К. т. н. А. Ф. Бондаренко

(КПИ им. Игоря Сикорского, г. Киев, Украина)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Акад. НАНУ, г. ф.-м. н. А. Е. Беляев (г. Киев, Украина)

Д. т. н. Н. М. Вакив (г. Львов, Украина)

Д. т. н. Г. А. Оборский (г. Одесса, Украина)

К. т. н. В. М. Чмиль В. (г. Киев, Украина)

Е. А. Тихонова (г. Одесса, Украина)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Д. т. н. С. Г. Антощук (г. Одесса, Украина)

Д. т. н. А. П. Бондарев (г. Львов, Украина)

Prof. I. Vajda (Budapest, Hungary)

Prof. D. Vinnikov (Tallinn, Estonia)

Prof. I. Galkin (Riga, Latvia)

К. т. н. Э. Н. Глущенко (г. Киев, Украина),
зам. главного редактора

К. т. н. Г. Г. Горох (г. Минск, Республика Беларусь)

Prof. K. Dhoska (Tirana, Albania)

Д. ф.-м. н. В. В. Должиков (г. Харьков, Украина)

Д. т. н. А. А. Дружинин (г. Львов, Украина)

Д. т. н. А. А. Ефименко (г. Одесса, Украина),
зам. главного редактора

Д. ф.-м. н. Д. В. Корбутяк (г. Киев, Украина)

Д. т. н. С. И. Круковский (г. Львов, Украина)

Чл.-кор. НАНУ, г. ф.-м. н. В. С. Лысенко (г. Киев,
Украина)

Prof. J. Martins (Caparica, Portugal)

Д. т. н. И. Ш. Невлюдов (г. Харьков, Украина)

Dr. Sc. D. Nika (Chisinau, Moldova)

Д. т. н. Ю. Е. Николаенко (г. Киев, Украина)

Prof. V. Pires (Setúbal, Portugal)

Д. ф.-м. н. С. В. Плаксин (г. Днепропетровск,
Украина)

К. т. н. Прокопец В. М. (г. Киев, Украина)

Prof. E. Romero-Cadaval (Badajoz, Spain)

К. ф.-м. н. А. В. Рыбка (г. Харьков, Украина)

К. т. н. П. С. Сафонов (г. Одесса, Украина),
отв. секретарь редколлегии

Д. т. н. В. Н. Сидорец (г. Киев, Украина)

Д. т. н. В. С. Ситников (г. Одесса, Украина)

Dr. Sc. Z. Stević (Belgrade, Serbia)

Д. х. н. В. Н. Томашек (г. Киев, Украина)

К. т. н. В. Е. Трофимов (г. Одесса, Украина)

Подписка на журнал

Отделения связи. «Каталог видань України». Индекс 23785.

В редакции «ТКЭА» можно подписаться с любого номера.

Контактная информация

Украина, 65044, г. Одесса, а/я 17;

tkea.journal@gmail.com, www.tkea.com.ua,

+38 099 444 63 52.

Редакция

*Е. А. Тихонова, А. А. Ефименко, П. С. Сафонов,
А. А. Алексеева, М. Г. Глава, Н. М. Колганова, Е. И. Корецкая.*